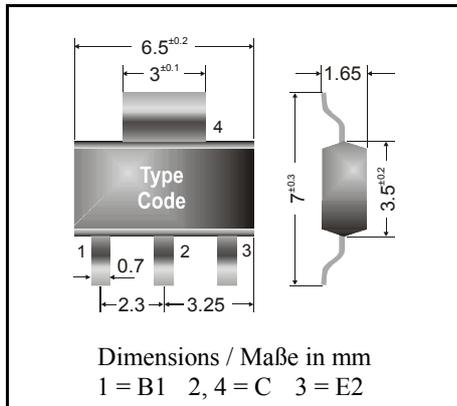


PNP

Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

PNP



Power dissipation – Verlustleistung	1.5 W
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-223
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

			BCP 28	BCP 48
Collector-Emitter-voltage	B open	$-V_{CE0}$	30 V	60 V
Collector-Base-voltage	E open	$-V_{CB0}$	40 V	80 V
Emitter-Base-voltage	C open	$-V_{EB0}$	10 V	
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	1.5 W ¹⁾	
Collector current – Kollektorstrom (DC)		$-I_C$	500 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	800 mA	
Base current – Basisstrom (DC)		$-I_B$	100 mA	
Peak Base current – Basisstrom		$-I_{BM}$	200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_S	- 65...+ 150°C	

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

				Min.	Typ.	Max.
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom						
$I_E = 0, -V_{CB} = 30\text{ V}$	BCP 28	$-I_{CB0}$		–	–	100 nA
$I_E = 0, -V_{CB} = 60\text{ V}$	BCP 48	$-I_{CB0}$		–	–	100 nA
$I_E = 0, -V_{CB} = 30\text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$	BCP 28	$-I_{CB0}$		–	–	10 μA
$I_E = 0, -V_{CB} = 60\text{ V}, T_A = 150^\circ\text{C}$	BCP 48	$-I_{CB0}$		–	–	10 μA
Emitter-Base cutoff current – Emitterreststrom						
$I_C = 0, -V_{EB} = 4\text{ V}$		$-I_{EB0}$		–	–	100 nA

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

